

C会場 彩雲

シンポジウム 11月27日(月)@C会場 彩雲

JCCG-46バルク成長分科会シンポジウム「バルクGaN開発に向けた結晶成長の最前線」

9:00	27a-C01	招	低コストGaNウエハの実現に向けて～ハロゲンフリー気相成長法による高速・高収率成長～	中村大輔、木村大至、堀渕嘉代、片岡恵太	豊田中研
9:30	27a-C02	招	トリハライド気相成長法によるGaN高温厚膜成長	村上尚1、竹川直1、熊谷義直1、山口晃2、松本功2、瀧野明伯1	1 農工大院工、2 大陽日酸
10:00	27a-C03	招	HVPEによるGaNの選択成長と高品位GaNの作製	岡田成仁、只友一行	山口大院創成
10:30			【休憩】		
10:45	27a-C04	招	OVPE法によるバルクGaN結晶成長技術の現状と展望	滝野淳一1、隅智亮1、岡山芳央1、信岡政樹1、北本啓2、今出完2、今西正幸2、吉村政志2、森勇介2	1 パナソニック、2 阪大院工
11:15	27a-C05	招	多光子PLを用いた、GaN基板・GaNエピ層中の転位観察	田中敦之 1,2、宇佐美茂佳 3、安藤悠人 3、永松謙太郎 1、新田州吾 1、本田善央 1、天野浩 1,2	1 名大 IMaSS、2 NIMS、3 名大院工

シンポジウム 11月27日(月)@C会場 彩雲

JCCG-46新技術・新材料分科会シンポジウム「エネルギーの有効利用に資する革新的技術」

13:30	27p-C01	招	ランガサイト型単結晶Ca ₃ (Ta, Nb)(Ga, Al) ₃ Si ₂ O ₁₄ の音響特性評価と圧電デバイスへの応用	大橋雄二1,井上憲司2,横田有為1,山路晃広3, 庄子育宏3,4,鎌田圭2,3,4,黒澤俊介1,5,吉川彰1,2,3,4	1 東北大NICHe, 2 Piezo Studio, 3 東北大金研, 4 C&A, 5 山形大理
14:00	27p-C02	招	圧電結晶球の超長距離伝搬超音波を用いた高感度ガスセンサの開発	辻俊宏1, 赤尾慎吾2,竹田宣生2,塚原祐輔2, 山中一司2,1	1. 東北大, 2. ボールウェーブ
14:30	27p-C03	招	原料連続供給法で育成されたPMN-PT及びPIN-PMN-PT単結晶	越前谷一彦, 中村啓一郎	JFEミネラル
15:00			【休憩】		
15:15	27p-C04	招	SiC溶液成長過程における転位伝播方向制御による高品質化	原田俊太1,2、村山健太1、村井良多3、朱燦1、田川美穂1,2、宇治原徹1,2,4	1. 名大未来研、2. 名大工、3. 名大VBL、4. 産総研
15:45	27p-C05	招	フラックス結晶育成のタンタル系光触媒薄膜作製への展開	鈴木清香1, 手嶋勝弥1,2	1 信大工, 2 信大環エネ研
16:15	27p-C06	招	強誘電体薄膜の結晶構造と電気特性の関係	新井貴司1、大野智也2、坂元尚紀3、脇谷尚樹3、松田剛2、鈴木久男3	1. 沼津高専, 2. 北見工大, 3. 静大電研

口頭発表 11月28日(火)@C会場 彩雲

半導体バルク

9:00	28a-C01		シリコン結晶成長の点欠陥の発生と消滅に関する一考察 (1) 引き上げ速度と温度勾配の関係	阿部孝夫、高橋 徹、白井光運*	信越半導体、阪大産研*
9:15	28a-C02		シリコン結晶成長の点欠陥の発生と消滅に関する一考察 (2) 格子間原子の発生機構	阿部孝夫、高橋 徹、* 白井光運	信越半導体、*阪大産研
9:30	28a-C03		Numerical simulation on 3D melt-crystal interface of floating zone (FZ) for silicon crystal growth	Xue-Feng Han, Xin Liu, Satoshi Nakano, Hirofumi Harada, Yoshiji Miyamura, Koichi Kakimoto	九大応力研
9:45	28a-C04		CZ炉内のCO濃度	宮村佳児、原田博文、中野智、柿本浩一	九大 応力研
10:00	28a-C05	賞	CZシリコン単結晶育成プロセスにおける炭素汚染の低減技術	永井勇太、坪田寛之、松村尚、中川聡子	グローバルウェーハズ・ジャパン
10:15			【休憩】		
10:30	28a-C06		SiC溶液成長におけるプロセス・インフォマティクス	宇治原徹、岡岡洋介、畑佐豪記、村山健太、村井良多、朱燦、原田俊太、田川美穂	名大・未来研、名大院工、GaN-OIL 産総研
10:45	28a-C07		Cr単一溶媒からのSiC溶液成長における溶質の輸送過程が成長形態に与える影響	鈴木皓己、玄光龍、太子敏則	信大・工、信大・環境エネ研
11:00	28a-C08		SiC溶液法における炭素濃度の経時変化を考慮した種子づけ条件の解析・検討	土本直道、山寄圭悟、高橋大、鈴木皓己、玄光龍、太子敏則	信大院工、信大環エネ研